

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
14 juillet 2005 (14.07.2005)

PCT

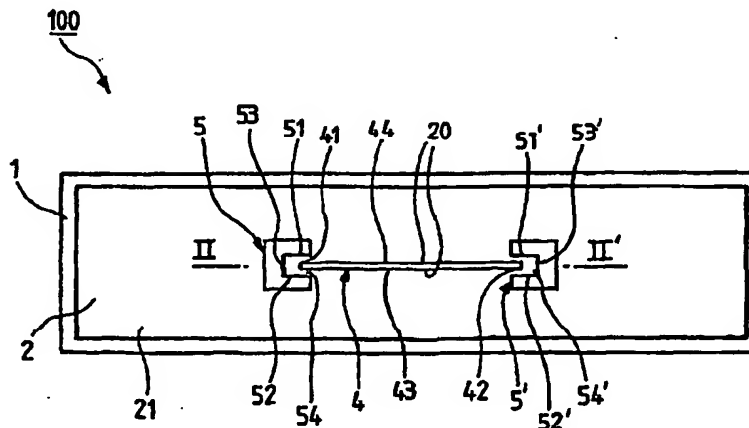
(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/064034 A3

- (51) Classification internationale des brevets⁷ : C23C 2/40, B05C 3/12, C30B 15/00, 28/10
- (21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2004/050674
- (22) Date de dépôt International : 10 décembre 2004 (10.12.2004)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité : 0351203 24 décembre 2003 (24.12.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf indication contraire) : SOT.AR-FORCE [FR/FR]; 25/29, Chemin Saint-André, F-69760 Limonest (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : BELOUET, Christian [FR/FR]; 1, rue Gaston Levy, F-92330 Sceaux (FR). REMY, Claude [FR/FR]; 25/59, Chemin Saint-André, F-69760 Limonest (FR).
- (74) Mandataires : LENNE, Laurence etc.; 39-41, avenue Aristide Briand, F-92163 Antony cedex (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DEVICE FOR DEPOSITING A POLYCRYSTALLINE SILICON LAYER ON A SUPPORT

(54) Titre : DISPOSITIF POUR DEPOSER UNE COUCHE DE SILICIUM POLYCRISTALLIN SUR UN SUPPORT



(57) Abstract: The invention relates to a device (100) for depositing a polycrystalline-silicon-based layer on a moveable, elongate, substantially planar support (4) having two longitudinal surfaces (43, 44) and two longitudinal lateral edges (41, 42), comprising: a crucible (1) containing a silicon-melt bath (2), said support being dipped at least partially into the bath and traversing the equilibrium profile (21) of the bath in a substantially vertical manner in the direction of the length of the elongate support; at least one element for controlling the edges (5, 5'), each edge-control element being maintained in a substantially vertical position close to one of the two longitudinal lateral edges (41, 42) and each edge-control element comprising partition walls (51 - 53') defining a longitudinal opening (54, 54') bordering on the corresponding longitudinal lateral edge and each opening being partially dipped into the bath (2) in order to raise the level of the bath by capillarity. The invention is characterized in that at least one of said partition insertion walls (51 - 52') partially opposite one of the longitudinal surfaces, is substantially planar.

[Suite sur la page suivante]